

5. В. И. Ерошкин, С. Н. Мальченко, В. В. Болдырев, А. В. Семешко, В. И. Горунов. Изучение селективности проявления светочувствительных систем на основе хлористого палладия.—«ЖНИПФИК», 1974, т. 19, № 4, с. 258.
6. Г. Беллио. Явление соляризации и скрытое изображение.—В кн.: Физические основы фотографической чувствительности. М., Изд-во иностр. лит., 1953, с. 248.

Поступила в редакцию 27 февраля 1975 г.

УДК 538.61

В. Г. ЖДАНОВ, В. К. МАЛИНОВСКИЙ

(Новосибирск)

ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТООПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ЗАПИСАННОЙ НА ТОНКИЕ МАГНИТНЫЕ ПЛЕНКИ (ТМП)

1. Технологические проблемы создания ТМП с перпендикулярной анизотропией ($MnBi$, $FePt$, $FePd$, $CoFe_2O_3$) в настоящее время практически решены, поэтому наиболее актуальна задача улучшения характеристик считывания записанной на ТМП информации.

Известно [1], что оптические и магнитооптические свойства тонких магнитных пленок с перпендикулярной анизотропией полностью определяются величинами комплексных показателей преломления для право (+)- и лево (-)-циркулярно-поляризованных волн $n_+ = n_+ + i\kappa$ и $n_- = n_- + i\kappa_-$. Магнитооптические свойства ТМП также характеризуют магнитное круговое двулучепреломление $\Delta n = n_+ - n_-$ и магнитный круговой дихроизм $\Delta \kappa = \kappa_+ - \kappa_-$. Знание комплексных показателей преломления магнитной среды достаточно для полного описания ее голограмических характеристик.

Линейно-поляризованный свет при прохождении через намагниченную пленку или при отражении от нее становится эллиптически-поляризованным, и азимут эллипса поляризации поворачивается на угол ϕ относительно поляризации падающего луча. Измерение состояния поляризации отраженного и прошедшего через образец с ТМП света позволяет определить оптические и магнитооптические свойства ТМП.

В традиционных схемах считывания битовой информации вклад в информационный сигнал I_s дает поворот плоскости поляризации ϕ , а эллиптичность ϵ является мешающим фактором, определяющим уровень фона.

Ниже рассмотрено решение задачи о способе визуализации эллиптичности и увеличении полезного сигнала при считывании записанной на ТМП информации.

2. Если на пути эллиптически-поляризованного света поместить компенсатор со сдвигом фаз Δ и определенным образом сориентировать ось компенсатора относительно оси эллипса, то после компенсатора можно получить линейно-поляризованный свет, который исключается анализатором.

Решим обратную задачу. Пусть через компенсатор проходит линейно-поляризованный свет с азимутом ϕ относительно оси компенсатора (рис. 1). После компенсатора получим эллиптически-поляризованный свет с параметрами $\operatorname{tg} \phi = E_y/E_x$ и $\delta = \delta_y - \delta_x = \Delta$. Оси x и y совпадают с осями компенсатора.

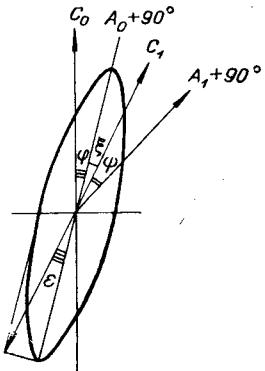


Рис. 1. Прохождение линейно-поляризованного света через компенсатор.

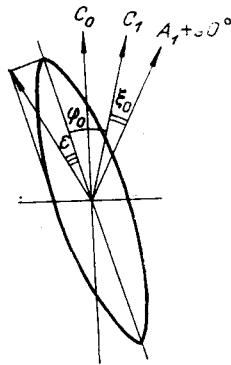


Рис. 2. Прохождение эллиптически-поляризованного света через произвольно ориентированные компенсатор и анализатор.

Большая ось этого эллипса повернута на угол ξ относительно оси компенсатора, и его эллиптичность ϵ . Причем [2]

$$\operatorname{tg} 2\xi = \operatorname{tg} 2\psi \cos \delta; \quad (1)$$

$$\sin 2\epsilon = \sin 2\psi \sin \delta. \quad (2)$$

Из решения ясно, под каким углом ξ необходимо расположить компенсатор со сдвигом фаз Δ , чтобы скомпенсировать эллиптичность ϵ . Если $\Delta=90^\circ$, то $\xi=0$, $\epsilon=\psi$.

Поляризационные элементы — компенсатор, поляризатор и анализатор — жестко связаны с углеродными устройствами. Начальные азимуты поляризатора P_0 и компенсатора C_0 — ось вдоль P_0 , анализатора A_0 — ось перпендикулярна P_0 . Эллиптически-поляризованный свет можно подавить поворотом компенсатора на угол C_1-C_0 и поворотом анализатора на угол A_1-A_0 . Из рис. 1 видно, что при этом

$$\xi = (C_1 - C_0) - \varphi; \quad (3)$$

$$\psi = (A_1 - A_0) - (C_1 - C_0). \quad (4)$$

Подставляя (3), (4) в (1) и (2), получим основные соотношения, связывающие магнитооптические параметры φ и ϵ с углами поворота компенсатора и анализатора:

$$\operatorname{tg} 2[(C_1 - C_0) - \varphi] = \operatorname{tg} 2[(A_1 - A_0) - (C_1 - C_0)] \cos \Delta; \quad (5)$$

$$\sin 2\epsilon = \sin 2[(A_1 - A_0) - (C_1 - C_0)] \sin \Delta. \quad (6)$$

Если компенсатор четвертьволновой, т. е. $\Delta=90^\circ$, то $C_1 - C_0 = \varphi$; $(A_1 - A_0) - (C_1 - C_0) = \epsilon$.

Таким образом, при одном направлении намагниченности в ТМП можно полностью погасить сигнал на детекторе, соответствующим образом повернув компенсатор и анализатор. Перемагничивание ТМП приводит к повороту азимута эллипса относительно P_0 на угол $-\varphi$, величина эллиптичности остается такой же ϵ , а направление вращения меняет знак.

3. При перемагничивании ТМП свет, прошедший компенсатор и анализатор, является полезным сигналом I_s . Связем величину I_s с магнитооптическими параметрами ТМП φ и ϵ . Для этого решим задачу о прохождении эллиптически-поляризованного света через произвольно ориентированные компенсатор и анализатор (рис. 2).

Эллиптически-поляризованный свет в прямоугольной системе координат x , y может характеризоваться либо параметрами ψ и δ ($\operatorname{tg} \psi = E_y/E_x$ — отношение проекций вектора E на оси x и y ; $\delta = \delta_y - \delta_x$ — сдвиг фаз между E_y и E_x), либо φ и ε (φ — азимут эллипса относительно оси координат, $\operatorname{tg} \varepsilon = b/a$ — отношение полуосей).

Эллипс в системе компенсатора (см. рис. 2) имеет параметры φ_0 и δ_0 . Причем [3]

$$\cos 2\varphi_0 = \cos 2\varphi_0 \cos 2\varepsilon_0; \quad (7)$$

$$\operatorname{tg} \delta_0 = \operatorname{tg} 2\varepsilon_0 / \sin 2\varphi_0. \quad (8)$$

После прохождения компенсатора формируется новый эллипс с параметрами φ_1 , ε_1 , ψ_1 и δ_1 :

$$\operatorname{tg} 2\varphi_1 = \operatorname{tg} 2\varphi_1 \cos \delta_1; \quad (9)$$

$$\sin 2\varepsilon_1 = \sin 2\varphi_1 \sin \delta_1; \quad (10)$$

$$\psi_1 = \varphi_0; \quad (11)$$

$$\delta_1 = \delta_0 + \Delta. \quad (12)$$

В системе анализатора этот же эллипс имеет параметры φ_2 и δ_2 :

$$\cos 2\varphi_2 = \cos 2(\varphi_1 + \xi_0) \cos 2\varepsilon_1; \quad (13)$$

$$\operatorname{tg} \delta_2 = \operatorname{tg} 2\varepsilon_1 / \sin 2(\varphi_1 + \xi_0). \quad (14)$$

Величина сигнала I_s пропорциональна $\sin^2 \varphi_2$. Из решения системы уравнений (7) — (14) можно получить φ_2 в явном виде. В приближении малых углов и если $\Delta = 90^\circ$, решение выглядит довольно просто:

$$I_s \sim \varphi_2^2 \approx (\varphi_0^2 + \varepsilon_0^2) + \xi_0^2 + 2\xi_0 (\varphi_0^2 + \varepsilon_0^2)^{1/2} \sin \left(\operatorname{arctg} \frac{\varepsilon_0}{\varphi_0} \right). \quad (15)$$

В случае магнитооптического считывания $\varphi_0 = 2\varphi$, $\varepsilon_0 = \varepsilon$, $\xi_0 = \xi$:

$$I_s \sim \varphi_2^2 \approx 4\varphi^2 + 2\varepsilon^2 + 2\varepsilon (4\varphi^2 + \varepsilon^2)^{1/2} \sin \left(\operatorname{arctg} \frac{\varepsilon}{2\varphi} \right). \quad (16)$$

Зависимость величины полезного сигнала I_s от φ и ε такова, что при малых φ и ε $I_s \sim 4\varphi^2 + 4\varepsilon^2$. Эллиптичность ε и угол вращения плоскости поляризации φ входят в выражение для полезного сигнала I_s равноправным образом.

Возможность визуализации эллиптичности связана противоположным направлениям вращения эллипсов поляризации при перемагничивании.

4. Экспериментальная установка (рис. 3) включает в себя следующие основные элементы: 1 — Не-Не лазер, $\lambda = 0,63 \text{ мк}$, 2 — модулятор, 3 — поляризатор (призма Глана), 4 — электромагнит, 5 — образец ТМП

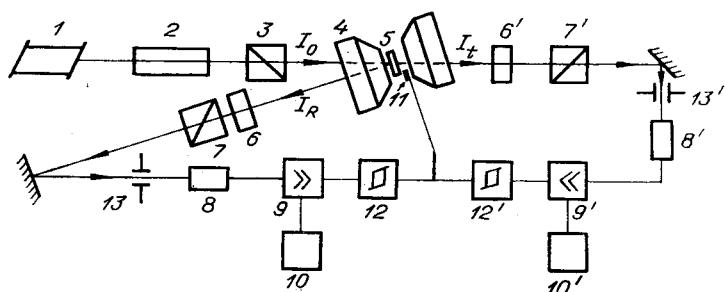


Рис. 3. Схема экспериментальной установки.

и юстировочная система, 6, 6' — четвертьволновые компенсаторы, 7, 7' — анализаторы (призмы Глана), 8, 8' — ФЭУ, 9, 9' — селективные усилители, 10, 10' — осциллографы, 11 — датчик Холла, 12, 12' — двухкоординатные самописцы, 13, 13' — диафрагмы.

Поляризационные элементы — призмы и компенсаторы — заключены в угломерные головки с ценой деления 1'. Электромагнит позволяет получать в зазоре 15 мм поля до 20 кЭ.

Первоначально производится юстировка схемы; вместо образца ТМП используется стеклянная плоскопараллельная пластинка. Азимут поляризатора P_0 , оси компенсаторов ориентируются вдоль P_0 и имеют свои азимуты $C_{\alpha 0}$ и $C_{\phi 0}$. Анализаторы выставляются перпендикулярно P_0 и исключают свет на ФЭУ, их азимуты соответственно $A_{\alpha 0}$ и $A_{\phi 0}$ (индекс k соответствует отраженному свету, ϕ — проходящему). Далее вместо стеклянной пластины вставляется ТМП и юстировочной системой отраженный поток заводится в центр диафрагмы перед ФЭУ; ТМП намагничивается до насыщения. Замеряются падающий I_0 , отраженный I_R и прошедший I_t потоки. Одновременным вращением компенсатора и анализатора устанавливается минимальный уровень сигнала на ФЭУ. Замеряются показания угломеров C_1 и A_1 . После перемагничивания пленки через систему проходит полезный сигнал I_s , величина которого измеряется.

Вращением компенсатора и анализатора добиваемся минимального сигнала на ФЭУ. Снимаем показания C_2 и A_2 . Если юстировка произведена правильно, то $(C_2 - C_0) = -(C_1 - C_0)$; $(A_2 - A_0) = -(A_1 - A_0)$, т. е. показания симметричны относительно нулевых положений. После этого по формулам (5), (6) производится вычисление магнитооптических параметров φ_k , ε_k , Φ_ϕ , ε_ϕ .

5. Преимущества разработанной схемы считывания перед стандартными отчетливо выявились при исследовании пленок MnBi. Сравним результаты измерений для одной из пленок, параметры которой $d=50$ нм, $\varphi_\phi=4^{\circ}2'$, $\varepsilon_\phi=2^{\circ}25'$, $\varphi_k=1^{\circ}46'$, $\varepsilon_k=2^{\circ}5'$. Пленка MnBi защищена покрытием из SiO толщиной 720 нм; $I_0=1$, $I_t=0,038$, $I_R=0,081$.

Измерения производились со стороны защитного покрытия. Полезный сигнал I'_s при обычной методике считывания:

$$I'_{s\phi} \approx I_t (4\varphi_\phi^2 + \varepsilon_\phi^2) = 8,5 \cdot 10^{-4};$$

$$I'_{sh} \approx I_R (4\varphi_k^2 + \varepsilon_k^2) = 4 \cdot 10^{-4}.$$

Остаточный сигнал $I'_{\text{ост}}$:

$$I'_{\text{ост.}\phi} \approx I_t \varepsilon_\phi^2 = 7 \cdot 10^{-5};$$

$$I'_{\text{ост.}k} \approx I_R \varepsilon_k^2 = 1,1 \cdot 10^{-4}.$$

При визуализации эллиптичности полезный сигнал I_s :

$$I_{s\phi} \approx I_t (4\varphi_\phi^2 + 4\varepsilon_\phi^2) = 10^{-3};$$

$$I_{sh} \approx I_R (4\varphi_k^2 + 4\varepsilon_k^2) = 7,3 \cdot 10^{-4}.$$

Остаточный сигнал $I_{\text{ост}}$:

$$I_{\text{ост.}\phi} \approx 0, \quad I_{\text{ост.}k} \approx 0.$$

По измеренным величинам φ_ϕ и ε_ϕ можно сделать элементарную оценку $n_+ - n_-$ и $\chi_+ - \chi_-$ в виде [1]

$$(n_+ - n_-) \pi d / \lambda \approx \varphi_\phi;$$

$$(\chi_+ - \chi_-) \pi d / \lambda \approx \varepsilon_\phi.$$

Для пленки, параметры которой приведены выше, $n_+ - n_- = 0,27$; $\chi_+ - \chi_- = 0,16$; $\lambda = 632$ нм.

Величина $\bar{\chi}$ может быть определена, если учесть, что коэффициент отражения образца со стороны подложки равен 0,4. Тогда для прошедшего света запишем

$$I_t \sim 0,6(I_0 - I_R) \exp(-\bar{\chi}4\pi d/\lambda).$$

Откуда $\bar{\chi} = 2,7$, т. е. величина дихроизма составляет $\approx 6\%$ для пленок MnBi.

Из приведенных экспериментальных данных видно, что предложенная схема позволяет свести к минимуму, определяемому качеством поляризационных элементов, остаточный сигнал при считывании. Возможность визуализации эллиптичности повышает уровень информационного сигнала и позволяет решить задачу оптимизации многослойных структур из тонких диэлектрических слоев и ТМП с целью нахождения максимума функций $I_R/I_0(\varphi_k^2 + \varepsilon_k^2)$ и $I_t/I_0(\varphi_\Phi^2 + \varepsilon_\Phi^2)$.

ЛИТЕРАТУРА

1. А. В. Соколов. Оптические свойства металлов. М., Физматгиз, 1961.
2. Л. В. Семененко, К. К. Свисташев, А. И. Семененко. Оптический поляризационный метод исследования поверхности полупроводников.— В кн.: Некоторые проблемы физики и химии поверхности полупроводников. Новосибирск, «Наука», 1972.
3. М. М. Горшков. Эллипсометрия. М., «Сов. радио», 1974.

Поступила в редакцию 22 октября 1975 г.

УДК 538.61

В. Г. ЖДАНОВ, Ю. Н. СЛЕСАРЕВ, В. Г. ЧУБАРОВ
(Новосибирск)

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ ОБРАЗЦОВ MnBi ПЛЕНОК

Одним из применений MnBi пленок является использование их для записи магнитных голограмм. Основная задача при этом — выбор режима записи, т. е. получение максимальной дифракционной эффективности (ДЭ) в восстановленном изображении при заданном уровне нелинейных искажений.

В данной работе проанализирована зависимость дифракционной эффективности от геометрии и условий записи и сделана попытка описания регистрирующих свойств MnBi пленок с помощью частотно-контрастной характеристики и характеристической кривой.

В работе [1] показано, что дифракционная эффективность описывается формулой

$$\eta \approx (4/\pi^2) \exp(-\alpha h) \sin^2(\pi C/D) \sin^2 \varphi, \quad (1)$$

где h — толщина пленки; α — коэффициент поглощения пленки; C — ширина переключаемого участка; D — период решетки; φ — угол фарадеевского вращения.

Дифракционная эффективность определяется шириной участка C , нагретого выше температуры Кюри, и углом фарадеевского вращения φ , который пропорционален намагниченности в переключенном участке. В свою очередь, намагниченность зависит от величины магнитных по-